

# Моделирование электрического пробоя методом диффузной границы

Пономарев А.С.<sup>1,2</sup>, Савенков Е.Б.<sup>2</sup>, Зипунова Е.В.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>МФТИ (НИУ)

<sup>2</sup>ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

66-я Всероссийская научная конференция МФТИ  
04.04.2024



- 1 Введение
- 2 Постановка задачи
- 3 Теоретический анализ
- 4 Численный анализ



- 1 Введение
- 2 Постановка задачи
- 3 Теоретический анализ
- 4 Численный анализ



## Электрический пробой

Явление резкого возрастания тока в диэлектрике при приложении электрического напряжения выше критического.

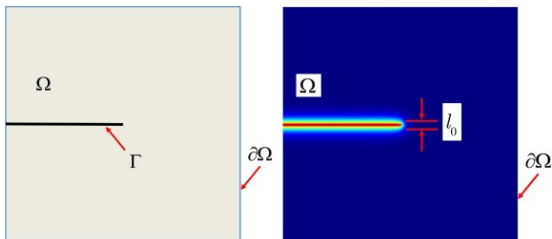
- Рассматриваем твердый диэлектрик
- Деградация диэлектрических свойств материала
- Процесс развивается в ограниченной зоне – канале
- Сложная физическая природа



## Модель типа диффузной границы

Вещество находится в разных фазах. Состояние вещества описывается гладкой функцией  $\phi(\mathbf{x}, t)$  – фазовым полем.

- $\phi = 1$  – неповрежденная среда
- $\phi = 0$  – полностью разрушенная среда
- Зона  $\phi \in (0, 1)$  – диффузная граница
- На разрушение среды тратится энергия



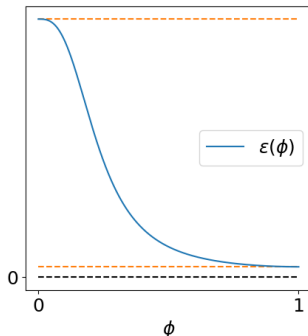
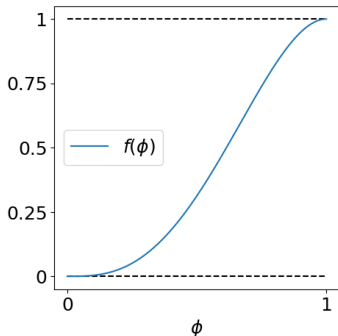
Модель, предложенная в работе [1]:

- $\pi = -\frac{1}{2}\epsilon[\phi](\nabla\phi, \nabla\phi) + \Gamma \left( \frac{1 - f(\phi)}{l^2} + \frac{1}{4}(\nabla\phi, \nabla\phi) \right)$  – плотность свободной энергии
- $\Gamma$  – энергия роста пробоя на единицу длины
- $l$  – величина «размытия» пробоя
- $\epsilon(\mathbf{x}, t)$  – диэлектрическая проницаемость среды
- $f(\phi)$  – интерполирующая функция



# Математическая модель

- $\epsilon(\mathbf{x}, t) = \frac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{f(\phi(\mathbf{x}, t)) + \delta}$  – диэлектрическая проницаемость среды
- $f(\phi) = 4\phi^3 - 3\phi^4$  – интерполирующая функция



## Уравнения модели

- Уравнение электрического потенциала  $\Phi$ :

$$\operatorname{div}(\epsilon[\phi]\nabla\Phi) = 0 \quad (1)$$

- Уравнение фазового поля  $\phi$ :

$$\frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2} \epsilon'(\phi) (\nabla\Phi, \nabla\Phi) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi) + \frac{1}{2} \Gamma \Delta \phi \quad (2)$$

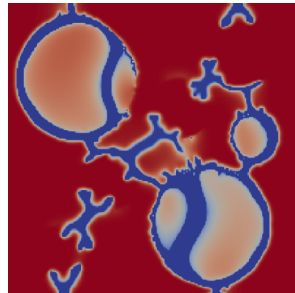
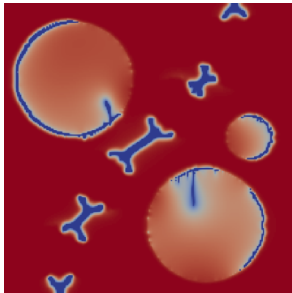
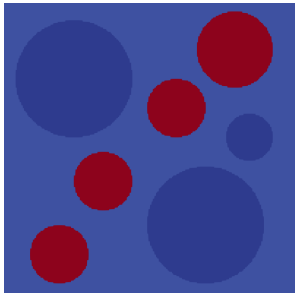
Свойства:

- связанная система уравнений на  $\phi$  и  $\Phi$ ;
- уравнение для  $\phi$  типа Аллена–Кана, нелинейное.





# Пример вычислительного эксперимента



Расчет из работы [2]



## Цель работы

Исследовать качественные характеристики системы уравнений (1), (2): условия развития канала пробоя, границы применения разностной схемы.

Для этого будем рассматривать задачу в определенных начальных условиях, упрощающих ее, но позволяющих установить интересные нас свойства.



- 1 Введение
- 2 Постановка задачи
- 3 Теоретический анализ
- 4 Численный анализ



# Одномерная задача

- Область  $\Omega = [0, w]_x \times [0, h]_y \times l_z$  в форме параллелепипеда;
- $\phi(\mathbf{x}, 0) = \phi_0(\mathbf{x}) = \phi_0(x)$ ,  $\epsilon_0(\mathbf{x}) = \epsilon_0(x)$  не зависят от  $y$  и  $z$ ;
- $\Phi|_{y=0} = \Phi^- \in \mathbb{R}$ ,  $\Phi|_{y=h} = \Phi^+ \in \mathbb{R}$ .

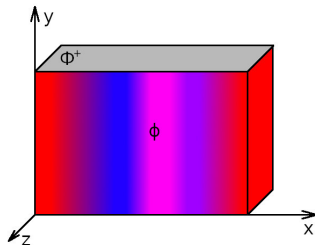
Решением является функция  
электрического потенциала

$$\Phi(x, t) = \Phi^- + \frac{y}{h}(\Phi^+ - \Phi^-)$$

Тогда уравнение на  $\phi$  принимает вид

$$\frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2} K_{\Phi}^2 \epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi) + \frac{1}{2} \Gamma \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$

$$K_{\Phi} = \frac{\Phi^+ - \Phi^-}{h}. \text{ Будем считать } \epsilon_0 = \text{const.}$$



- 1 Введение
- 2 Постановка задачи
- 3 Теоретический анализ**
- 4 Численный анализ



- Пробой может развиваться из малых возмущений свойств неповрежденной среды. Выясним условия развития.
- Рассмотрим положения равновесия вида  $\phi(x, t) \equiv C$ . Положению равновесия соответствует ноль  $C$  функции

$$\chi(\phi) = \frac{1}{2}K_{\Phi}^2\epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2}f'(\phi)$$

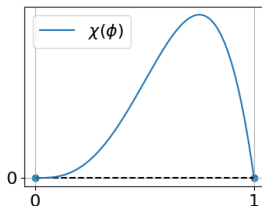
- Исследуем положения равновесия на устойчивость спектральным методом: к  $\phi \equiv C$  прибавим возмущение  $\delta\phi = e^{\alpha t} \cos(\omega x)$ , линеаризуем уравнение на  $\delta\phi$
- $\chi(\phi)$  возрастает в  $C \implies$  равновесие неустойчиво;  $\chi(\phi)$  убывает в  $C \implies$  равновесие устойчиво



# Анализ положений равновесия

«Слабое»  
напряжение

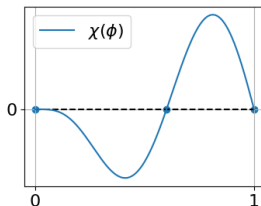
$$0 \leq \frac{K_{\Phi}^2 I^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < \delta^2$$



$\phi \equiv 0$  неустойчивое  
 $\phi \equiv 1$  устойчивое

«Среднее»  
напряжение

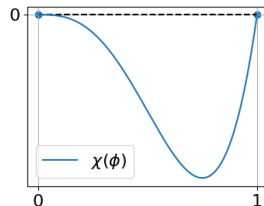
$$\delta^2 < \frac{K_{\Phi}^2 I^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < (1+\delta)^2$$



$\phi \equiv 0$  устойчивое  
 $\phi \equiv C_3$  неустойчивое  
 $\phi \equiv 1$  устойчивое

«Сильное»  
напряжение

$$(1+\delta)^2 < \frac{K_{\Phi}^2 I^2 \epsilon_0}{2\Gamma}$$



$\phi \equiv 0$  устойчивое  
 $\phi \equiv 1$  неустойчивое



- 1 Введение
- 2 Постановка задачи
- 3 Теоретический анализ
- 4 Численный анализ





## Разностная задача

$$\frac{1}{m} \frac{\phi_a^{b+1} - \phi_a^b}{\tau} = \frac{1}{2} K_\phi^2 \epsilon'(\phi_a^b) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi_a^b) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{a+1}^b - 2\phi_a^b + \phi_{a-1}^b}{h^2}$$

$$\phi_a^0 = \phi_0(ah); \quad \phi_0^b = \phi_l(b\tau); \quad \phi_{w/h}^b = \phi_r(b\tau)$$

Сетка регулярная;  $\tau$  – шаг по времени,  $h$  – шаг по пространству.

Явная разностная схема первого порядка по времени, второго – по пространству.



- Рассмотрим возмущенное решение  $\phi_a^b + \delta_a^b$ . Линеаризуем уравнение на возмущение  $\delta_a^b$  в точке  $\phi_a^b = P$ :

$$\delta_a^{b+1} = \delta_a^b + m\tau \left( \frac{1}{2}K_\Phi^2 \epsilon''(P) \delta_a^b + \frac{\Gamma}{l^2} f''(P) \delta_a^b + \frac{\Gamma}{2} \frac{\delta_{a+1}^b - 2\delta_a^b + \delta_{a-1}^b}{h^2} \right)$$

- Применим спектральный признак устойчивости:

$$1 > \lambda(\theta) = 1 + m\tau \left( \frac{1}{2}K_\Phi^2 \epsilon''(P) + \frac{\Gamma}{l^2} f''(P) - \frac{2\Gamma}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

- Исследуем вблизи 0.



## Условие устойчивости

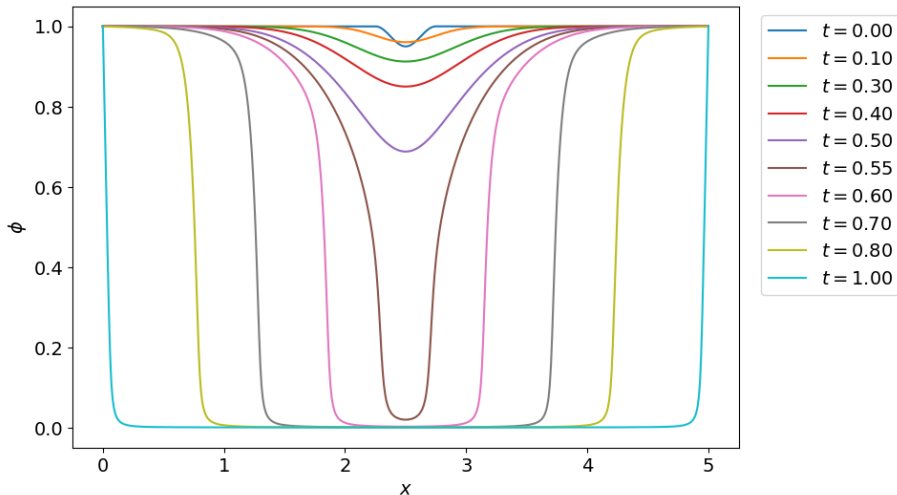
$$\tau \leq \frac{1}{2m \left( \frac{K_{\Phi}^2 \epsilon_0}{\delta^{5/3}} + \frac{\Gamma}{h^2} \right)}$$

## Упрощенное условие устойчивости

$$\tau \leq \frac{1}{4m} \min \left( \frac{\delta^{5/3}}{K_{\Phi}^2 \epsilon_0}, \frac{h^2}{\Gamma} \right)$$



# Вычисления: типичное решение

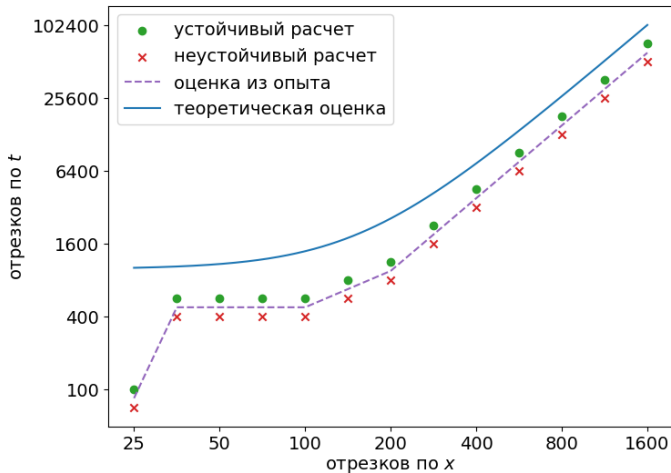


Узлов по измерениям:  $n_x = 10^3$ ,  $n_t = 10^5$



ИФТИ

# Вычисления: проверка устойчивости

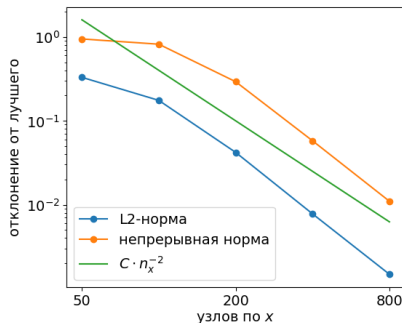
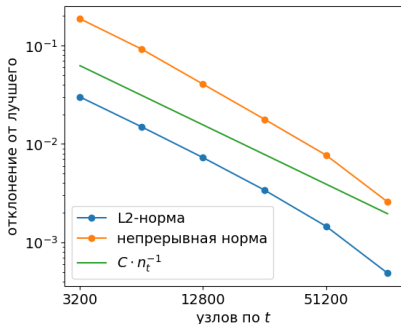


$$\tau \leq \frac{1}{2m} \left( \frac{K_{\Phi}^2 \epsilon_0}{\delta^{5/3}} + \frac{\Gamma}{h^2} \right)^{-1}$$

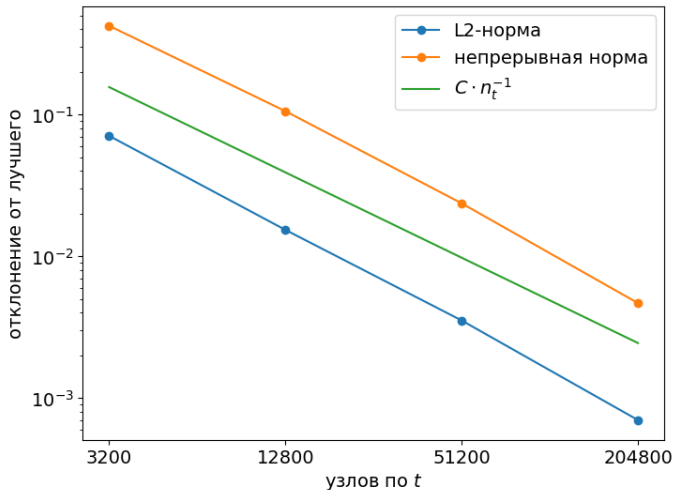


# Вычисления: проверка сходимости

Проводится ряд вычислений, затем результаты сравниваются по норме с лучшим в ряду.



# Вычисления: проверка сходимости

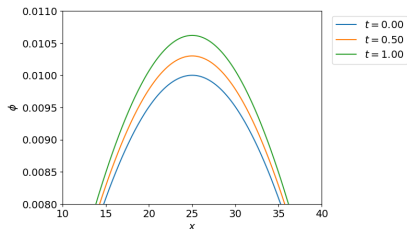


Здесь, согласно оценке устойчивости,  $\tau = \frac{h^2}{4m\Gamma}$

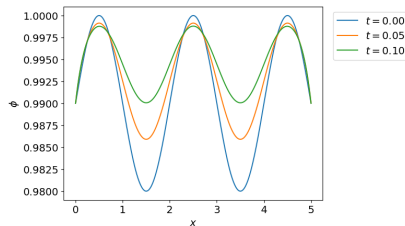


# Вычисления: положения равновесия

$$0 \leq \frac{K_{\Phi}^2 I^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < \delta^2 - \text{«слабое» напряжение}$$



$\phi \equiv 0$   
неустойчивое



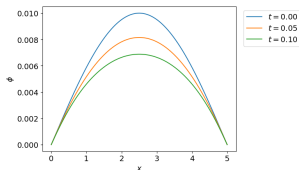
$\phi \equiv 1$   
устойчивое



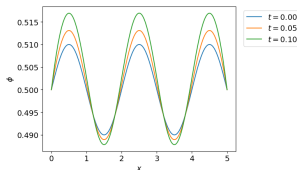


# Вычисления: положения равновесия

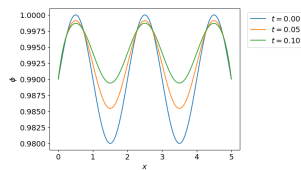
$$\delta^2 < \frac{K_{\Phi}^2 I^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < (1 + \delta)^2 - \text{«среднее» напряжение}$$



$\phi \equiv 0$   
устойчивое



$\phi \equiv C_3$   
неустойчивое

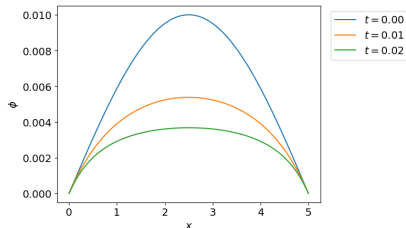


$\phi \equiv 1$   
устойчивое

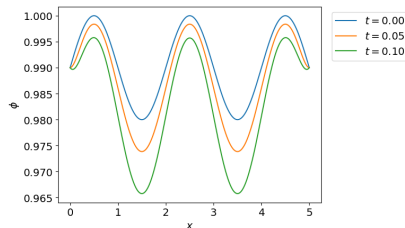


# Вычисления: положения равновесия

$$(1 + \delta)^2 < \frac{K_{\Phi}^2 I^2 \epsilon_0}{2\Gamma} - \text{«сильное» напряжение}$$



$\phi \equiv 0$   
устойчивое



$\phi \equiv 1$   
неустойчивое



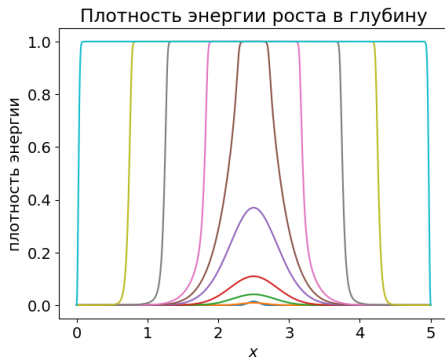
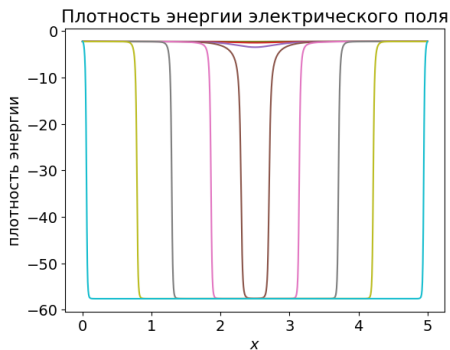
$$\Pi(t) = \int_{\Omega} \pi(x, t) dx$$

$$\pi(x, t) = \pi_1(x, t) + \pi_2(x, t) + \pi_3(x, t)$$

- $\pi_1(x, t) = -\frac{K_{\Phi}^2}{2} \epsilon(\phi(x, t))$  – плотность энергии электрического поля;
- $\pi_2(x, t) = \Gamma \frac{1 - f(\phi(x, t))}{l^2}$  – плотность энергии роста пробоя;
- $\pi_3(x, t) = \frac{\Gamma}{4} \left( \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, t) \right)^2$  – плотность энергии образования граничной зоны пробоя

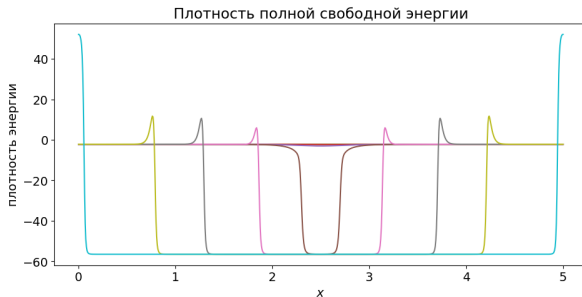
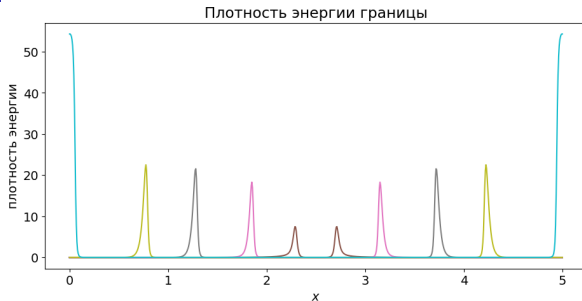


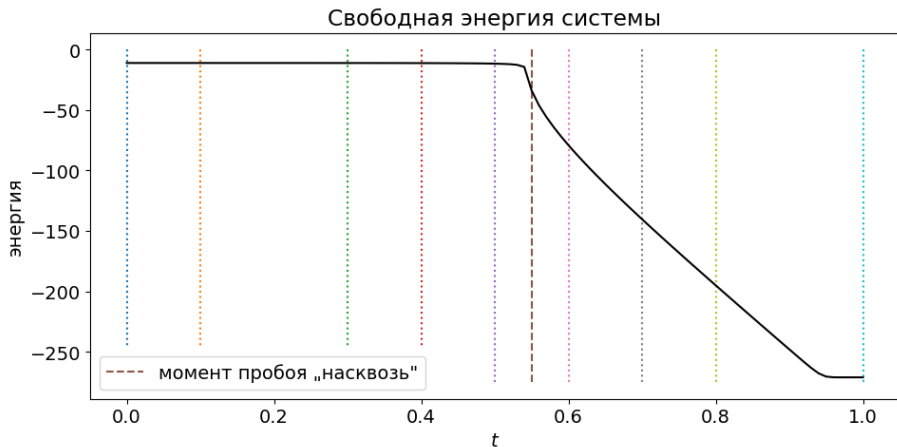
# Вычисления: свободная энергия





ИФМ

# Вычисления: свободная энергия





-  Е.В. Зипунова и Е.Б. Савенков. *О моделях диффузной границы для описания динамики объектов высшей коразмерности.* Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. Москва, 2020.
-  Е.В. Зипунова, А.А. Кулешов и Е.Б. Савенков. *Численное исследование модели фазового поля для описания развития канала электрического пробоя в неоднородной среде.* Сибирский журнал индустриальной математики. 2024.



Спасибо за внимание

